

# 高密度等离子体刻蚀机

High Density Plasma Etching System

ICP-100



微电子所设备



固体物理所设备



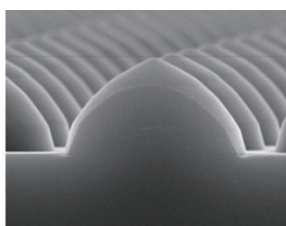
## 性能指标

- 刻蚀速率: Si  $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{min}$ 、SiO<sub>2</sub>  $\geq 0.2 \mu\text{m}/\text{min}$
- 非均匀性: 4 英寸样片  $\leq \pm 5\%$
- 刻蚀材料: 石英、蓝宝石、Si
- 气路系统: 标配 6 路进气, 可定制

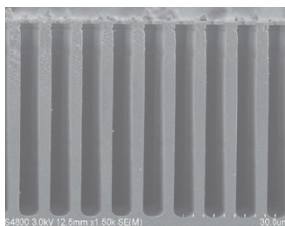
## 主要应用

用于微电子、光电子器件的刻蚀

## 代表性应用成果



0.5  $\mu\text{m}$  蓝宝石图形刻蚀



高深宽比深硅刻蚀



多阶光栅刻蚀

主要用户单位	清华大学、北京大学、天津大学、中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心		
研制单位	中国科学院微电子研究所、泰龙电子技术有限公司、中国科学院固体物理研究所		
联系方式	何老师	010-62049399, 13581817539	hemeng@ime.ac.cn
	李新化	0551-65591402, 15105601736	xihuali@issp.ac.cn